

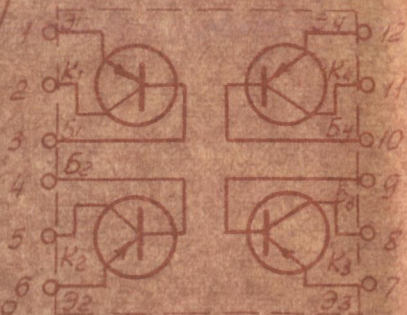


Паспорт

ТРАНЗИСТОРНЫЕ МАТРИЦЫ

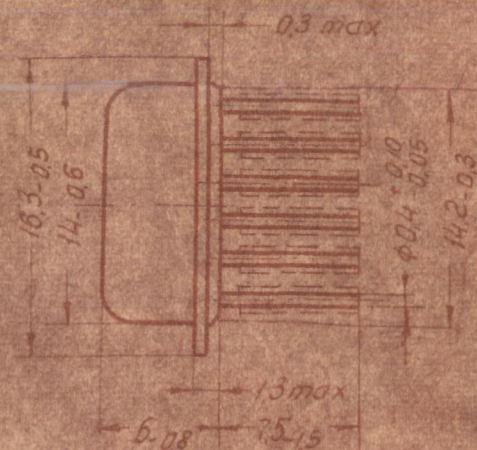
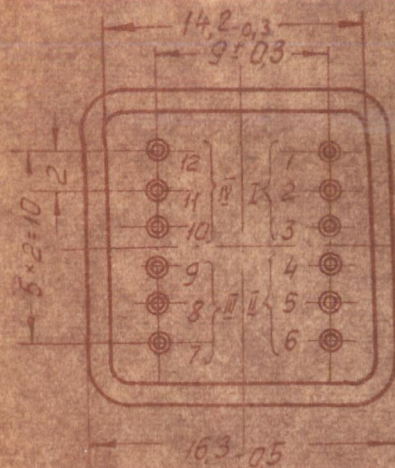
ТИПОВ: ГТС609А,
ГТС609Б, ГТС609В
З. 456.000-2ТУ

Вес не более 4 гр
В одном приборе содержится
серебра 6р9999-0,01623гр



Электрические параметры при $+20^\circ \pm 5^\circ$

Параметр	Типы			Режим измерения
	А	Б	В	
I_{CE}	не менее	30	50	80
	не более	100	160	240
$I_{св.в.ма}$ не более	40	40	40	$I_C = 0,5a; U_C = 3b$
$I_{св.в.ма}$ не более	200	200	200	$U_C = 2,5b$
$U_{CE sat.в}$ не более	1,6	1,6	1,6	$I_C = 0,5a$
$U_{CE sat.в}$ не более	1,1	1,1	1,1	для типа А
$t_{св.в.ма}$ не более	0,7	0,7	0,7	$I_B = 70 ма$
$t_{ол.в.ма}$ не более	0,1	0,1	0,1	для типа Б В
				$I_B = 40 ма$
$\alpha_{a.в}$ не менее	30	30	30	$I_C = 0,5a; t = 5 мсек$
$\rho_{с.в.пф}$ не более	50	50	50	$U_C = 10b; f = 5 мГц$
$\rho_{с.в.пф}$ не более	250	250	250	$U_C = 0,5b; f = 2 мГц$



$I_{св.в.ма}$
 $I_{св.в.ма}$

Обозначение выводов 16, 7, 12 - эмиттеры,
2, 5, 8, 11 - коллекторы, 3, 4, 9, 10 - базы.
I, II, III, IV - единичные транзисторы.

Допустимые режимы эксплуатации.

(в диапазоне температур от минус $40^\circ C$ до $+60^\circ C$)

- $U_{CE}^{*max} = 50b;$
- U_{CE}^{*max} (при U_{CE} - минус 0,5b - минус 0,7b) - 50b
- $U_{CE}^{*max} = 2,5b;$
- $I_{св.в.ма}^{*max}$ (при $t_{имп} \leq 10 мсек$) - 0,7a;
- $I_{св.в.ма}^{*max}$ (при $t_{имп} \leq 10 мсек$) - 0,1a;
- $P_c^{*max} = 500 мВт$ (при $t_{отб} = \text{минус } 40^\circ C \div 43^\circ C$)
- $P_c^{*max} = \frac{85 - t_{отб}}{0,084}$ (при $t_{отб} = 43^\circ \div 60^\circ C$)
- $P_{св.в.ма}^{*max} = 5b мВт$ (при $t \leq 10 мсек$ и любой комбинации включения проводных структур) на каждую структуру

* При условии не превышения мощности рассеиваемой транзисторной матрицей.

** Постоянный ток определяется из условий не превышения мощности рассеиваемой транзисторной матрицей.

Указания и рекомендации по эксплуатации

1. При эксплуатации необходимо выполнять требования Руководства по применению п/п приборов НО.332.004.

2. Допускается изгиб и пайка выводов на расстоянии не менее 3мм от корпуса. Допускается любой вид пайки, обеспечивающий нагрев в любой точке корпуса не более $+90^{\circ}\text{C}$.

3. При эксплуатации транзисторных матриц в условиях механических ускорений более $2g$, транзисторные матрицы необходимо крепить за корпус.

4. Запрещается эксплуатация транзисторов транзисторной матрицы с отключенной базой по постоянному току.

5. Допускается любая комбинация и последовательность включения транзисторов в транзисторной матрице при условии неперевышения допустимой мощности рассеивания.

6. Не рекомендуется эксплуатация транзисторных матриц при рабочих температурах, измеряемых с обратными неуправляемыми переходами во всем диапазоне температур.

Гарантированные показатели

1. Гарантийная наработка (срок службы) в режимах и условиях допускаемых ТУ не менее 8000 час.

2. Срок сохраняемости приборов в упаковке поставщика в ЗИПе, а также вмонтированных в аппаратуру при хранении их в складских условиях не менее 12 лет.

ОТК просит по окончании эксплуатации приборов возвратить заполненный паспорт предприятию изготовителю по адресу:

г. Рига-37, п/я Р-6432.

Дата включения _____

Дата выключения _____

Число фактических часов работы _____

Основные данные режима эксплуатации _____

Причины выхода из строя _____

Адрес потребителя _____

Начальник ОТК _____